

Achieving accuracy in charge carrier mobility modelling in silicon

Mnatsakanov, T.T.; Gresserov, B.N.; Pomortseva, L.I. Automation, simulation & measurement : ASM'91 : 3rd biennial conference, Tallinn, October 7-11, 1991. Section S / Tallinn Technical University 1992 / p. 89-94: ill

Modelling of charge carrier non-isothermal transport in silicon and silicon carbide

Velme, Enn; Udal, Andres Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Engineering 2000 / 2, p. 144-154 : ill
https://artiklid.elnet.ee/record=b1004044*est

On the charge carrier time-of-flight mobility and the ordering effects in the microcrystalline PEDOT/PSS complex : a morphology-based simulation study

Kaevand, Toomas; Kalda, Jaan; Lille, Ülo International journal of renewable energy and biofuels 2013 / p. 1-13 : ill

Инжекционные зависимости времени жизни неосновных носителей заряда в кремнии, легированном золотом и платиной

Udal, Andres Силовые быстродействующие полупроводниковые приборы : сборник статей. Часть II 1989 / с. 101-105 : ил, табл https://www.ester.ee/record=b1264433*est

К вопросу об эффективной длине диффузии носителей заряда в условиях перепоглощения рекомбинационного излучения

Velme, Enn Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции "Современные методы и устройства радиоэлектронного оборудования", посвященной Дню радио. Секция: полупроводниковые приборы 1981 / с. 32-33
https://www.ester.ee/record=b1310801*est

Лавинное размножение носителей заряда в дополнительных р-п-переходах

Velme, Enn Расчет и проектирование приборов, устройств и систем технической кибернетики 1981 / с. 3-14 : ил
https://www.ester.ee/record=b1319172*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/4c9b1559-97b9-4d9b-bac8-6c40840ba442>

Моделирование концентрации носителей заряда в полупроводниках

Rang, Toomas Исследования по прикладной квантовой электронике 1987 / с. 26-36

Приближенный метод исследования переноса неравновесных носителей заряда в варизонных полупроводниках с учетом перепоглощения рекомбинационного излучения

Velme, Enn Полупроводники и гетеропереходы : сборник статей 1987 / с. 12-14 https://www.ester.ee/record=b1262177*est

Проблемы оптимизации аксиального профиля времени жизни носителей заряда в структуре быстродействующего тиристора

Surma, A.; Udal, Andres; Assina, Svetlana Силовые быстродействующие полупроводниковые приборы : сборник статей. Часть II 1989 / с. 18-21 : ил https://www.ester.ee/record=b1264433*est

Расчет коэффициента переноса неосновных носителей заряда в условиях перепоглощения межзонного рекомбинационного излучения

Velme, Enn Полупроводниковые гетеропереходы : тезисы докладов II республиканской конференции, Эдьва 24-26 ноября 1982 г. 1982 / с. 25 https://www.ester.ee/record=b1304403*est